



МИКРОСХЕМА КР537РУ13А, КР537РУ13

Э Т И К Е Т К А

Интегральная микросхема КР537РУ13А, КР537РУ13 - статическое оперативное запоминающее устройство с произвольной выборкой информационной емкостью 4096 бит и организацией 1024 x 4 бит, предназначена для использования в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения.

Схема расположения выводов микросхем КР537РУ13А, КР537РУ13

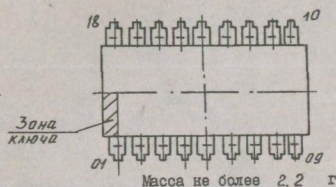


Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода
01	Вход адреса A0
02	Вход адреса A1
03	Вход адреса A2
04	Вход адреса A3
05	Вход адреса A7
06	Вход адреса A8
07	Вход адреса A9
08	Вход сигнала "Выбор микросхемы" $\overline{CS}$
09	Общий вывод 0V

Продолжение

Номер вывода	Назначение вывода
10	Вход сигнала "Запись," $\overline{WR}$
11	Вход-выход информации D11/D01
12	Вход-выход информации D12/D02
13	Вход-выход информации D13/D03
14	Вход-выход информации D14/D04
15	Вход адреса A6
16	Вход адреса A5
17	Вход адреса A4
18	Вывод питания от источника напряжения U

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ

$\theta_a = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение высокого уровня, В, $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $I_{DN} = -2,0 / \text{мА}$, $I_{DN} = -0,4 / \text{мА}$	U_{OH}	2,8	$U_{CC} - 1,2 В$

Продолжение			
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение низкого уровня, В $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $I_{OL} = 4 мА$, $U_{IL} = 0,8 В$, $U_{IH} = 2,0 В$	U_{OL}		0,4
Напряжение питания в режиме хранения, В $U_I = 0 В$, $U_{CS} = U_{CCS}$	U_{CCS}	2,0	
Ток утечки низкого уровня на входе, мкА $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $U_{IL} = 0 В$	I_{LIL}		/-1,0/
Ток утечки высокого уровня на входе, мкА $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $U_{IH} = U_{CC}$	I_{LIH}		1,0
Ток утечки низкого уровня на выходе, мкА $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $U_{OL} = 0 В$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0$	I_{LOL}		/-10/
Ток утечки высокого уровня на выходе, мкА $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $U_{OH} = U_{CC}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0$	I_{LOH}		10
Ток потребления в режиме хранения, мкА $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $U_{IL} = 0 В$, $U_{IH} = U_{CC}$ $U_{CC} = 2,0 В$, $U_{IL} = 0 В$, $U_{IH} = U_{CC}$	I_{CCS}		5,0 2,0
Динамический ток потребления, мА $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $S = \frac{1}{2 t_{cy}(RD)}$ МГц, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0$	I_{CCO}		50
Время выборки адреса, нс $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $C_L = 50 пФ$ для микросхем КР537РУ13А КР537РУ13	$t_{A(A)}$		95 160
Время выбора, нс $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $C_L = 50 пФ$ для микросхем КР537РУ13А КР537РУ13	t_{CS}		95 160
Время цикла записи, нс, $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $C_L = 50 пФ$ для микросхем КР537РУ13А КР537РУ13	$t_{CV(WR)}$	95 160	-
Время цикла считывания, нс, $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $C_L = 50 пФ$ для микросхем КР537РУ13А КР537РУ13	$t_{CY(RD)}$	95 160	-
Длительность сигнала записи, нс, $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $C_L = 50 пФ$ для микросхем КР537РУ13А КР537РУ13	$t_{W(WR)}$	65 110	-
Время установления сигнала записи относительно сигнала адреса, нс, $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $C_L = 50 пФ$ для микросхем КР537РУ13А КР537РУ13	$t_{SU(A-WR)}$	15 25	-
Время установления сигнала выбора относительно сигнала адреса, нс, $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$, $C_L = 50 пФ$ для микросхем КР537РУ13А КР537РУ13	$t_{SU(A-CS)}$	15 25	-

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. МИКРОСХЕМ

Золото — г

Серебро — г

в том числе

золото — г/мм на выводах длиной 1 мм

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы КР537РУ13А, КР537РУ13 соответствуют техническим условиям ОК0.348.532-13 ТУ

Место для
штампа ОТК

Место для штампа "Пере проверка произведена _____"

Место для
штампа ОТК